

トランジスタ

T-33-17

2SA914

2SA914

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形/Si PNP Epitaxial Planar

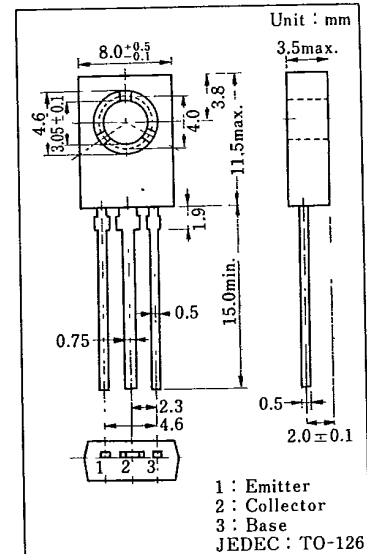
低周波電力前置増幅用/AF Power Pre-amplifier
2SC1953 とコンプリメンタリ/Complementary Pair with
2SC1953

■ 特徴/Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} の直線性がよい。/Good linearity of h_{FE}
- コレクタ・エミッタ電圧 V_{CEO} が高い。/High V_{CEO}
- コレクタ出力容量 C_{ob} が小さい。/Low C_{ob}

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	150	V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	150	V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CP}$	100	mA
コレクタ電流	$-I_C$	50	mA
コレクタ損失	P_C	1	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしや断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB} = 100\text{ V}, I_E = 0$			1	μA
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C = 0.1\text{ mA}, I_B = 0$	150			V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E = 10\text{ }\mu\text{A}, I_C = 0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$-V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 10\text{ mA}$	90		450	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C = 30\text{ mA}, -I_B = 3\text{ mA}$			1	V
トランジション周波数	f_T	$-V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 10\text{ mA}$		200		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$-V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$			5	pF

* h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

Class	Q	R	S	T
h_{FE}	90~155	130~220	185~330	260~450

トランジスタ

T-33-17

2SA914

